

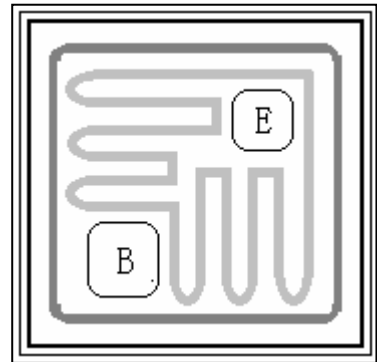


5401 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：A046AJ-00
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：460 × 460μm²
 焊位尺寸：B 极 110×110μm²；E 极 110×110μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2N5401，H5401

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极耗散功率..... 625mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压..... -160V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... -150V
 V_{EBO}——发射极—基极电压..... -5V
 I_C——集电极电流..... -600mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.05	μA	V _{CB} =-120V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.05	μA	V _{EB} =-3V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	30				V _{CE} =-5V, I _C =-1mA
		60		280		V _{CE} =-5V, I _C =-10mA
		50				V _{CE} =-5V, I _C =-50mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-0.2	V	I _C =-10mA, I _B =-1mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			-0.5	V	I _C =-50mA, I _B =-5mA
				-1	V	I _C =-10mA, I _B =-1mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-160			V	I _C =-100μA, I _E =0
						V
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-150			V	I _C =-1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-10μA, I _C =0
f _T	特征频率	100		400	MHz	V _{CE} =-10V, I _C =-10mA f=100MHz